



美光送样 256GB DDR5 服务器内存模块 重新定义 AI 性能

May 21, 2026 at 11:00 AM CST

采用 1-gamma DRAM 与先进封装技术，为业界提供更快性能

2026 年 5 月 14 日，爱达荷州博伊西市 — 美光科技公司（纳斯达克股票代码：MU）近日宣布，已向核心服务器生态系统合作伙伴送样 256GB DDR5 RDIMM 内存模块。该模块基于美光领先的 1-gamma 制程打造，传输速率最高可达 9,200 MT/s，比当前量产的内存模块快 40% 以上。¹

此款模块采用先进封装工艺，结合 3D 堆叠（3DS）与硅穿孔（TSV）工艺，将多颗内存晶粒整合于单一模块中。搭配美光 1-gamma DRAM 技术，这些创新成果提供了扩展下一代 AI 系统所需的容量、速率和能效。与两个 128GB 模块相比，单个 256GB 模块可降低 40% 以上的运行功耗，为现代 AI 数据中心带来更高能效。²

生态系统合作伙伴验证

美光正与核心生态系统合作伙伴协作，在其当前及新一代服务器平台上对 256GB 1-gamma DDR5 RDIMM 进行验证。通过联合兼容性测试，可确保该产品具备广泛的平台兼容性，并帮助大规模构建人工智能（AI）和高性能计算（HPC）基础设施的数据中心客户加速量产部署。

美光高级副总裁暨云端存储事业部总经理 Raj Narasimhan 表示：“容量、带宽和功耗是决定 AI 效率的核心因素。美光 256GB DDR5 RDIMM 将能够显著提升服务器性能。该解决方案基于我们的 1-gamma DRAM 技术，采用先进的 3DS 和 TSV 封装技术，提供业界领先的速率和能效，帮助数据中心架构师更高效地扩展 AI 基础设施。”

满足 AI 时代的内存需求

大语言模型（LLM）、智能体 AI（agentic AI）、实时推理及高核数 CPU 负载场景快速普及，正推动企业对更大容量、更高带宽和更优能效的服务器内存需求迅速增长。美光 256GB DDR5 RDIMM 精准匹配行业增长诉求，助力服务器架构师、超大规模云厂商及硬件平台合作伙伴，在现代数据中心散热与功耗约束下，最大化单插槽内存配置容量。

送样与供货情况

目前，美光 1-gamma 制程 256GB DDR5 RDIMM 已向核心服务器生态伙伴送样，开展平台验证。如需了解更多美光数据中心解决方案信息，请访问[美光数据中心内存网页](#)。

关于 Micron Technology Inc.（美光科技股份有限公司）

美光科技是创新内存和存储解决方案的业界领导厂商，通过改变世界使用信息的方式来丰富全人类生活。我们始终以客户为中心，专注引领技术创新，追求卓越制造与运营，向客户交付丰富的高性能内存和存储产品组合——包括 DRAM、NAND 及 NOR。美光团队打造的创新产品，每一天都助力数据经济的发展，推动人工智能（AI）和计算密集型应用的突破，释放从数据中心到本地智能设备的无限机遇。如需了解 Micron Technology Inc.（美光科技股份有限公司，纳斯达克股票代码：MU）的更多信息，请访问[micron.cn](#)

© 2026 Micron Technology Inc.（美光科技股份有限公司）保留所有权利。信息、产品和/或规格如有变更，恕不另行通知。Micron、Micron 徽标和所有其他 Micron 商标均为 Micron Technology Inc.（美光科技股份有限公司）所属商标。所有其他商标分别为其各自所有者所有。

美光媒体联络人

高诚公关

潘平 / 美光服务团队

电话：+86 188 8388 2632

E-mail: ppan@golin.com

[1] 性能优势基于 9,200 MT/s 与 6,400 MT/s 产品的对比计算得出。

[2] 运行功耗以瓦特（W）为单位测量。通过对比两个运行功率为 9.7W 的 128GB 模块（总功率 19.4W）与单个运行功率为 11.1W 的 256GB 模块计算得出。